(9) 日本国特許庁 (JP)

即特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭57—117171

⑤Int. Cl.³G 11 C 11/14 19/08 識別記号

庁内整理番号 7341-5B 砂公開 昭和57年(1982)7月21日

発明の数 1 審査請求 有

(全 3 頁)

砂磁気パブルメモリ素子

②特

願 昭55-173090

22出

願 昭55(1980)12月10日

⑫発 明 者 柳瀬武泰

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

@発 明 者 天津正史

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

の出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

個代 理 人 弁理士 青木朗

外3名

明 総 書

1. 発明の名称

磁気パブルメモリ業子

2. 特許請求の範囲

1 パーマロイ等の軟磁性パターンを用いてパブル磁区の転送制御が行なわれ、情報を格納する複数個のマイナーループと、一対の観出し及び等込みラインと、転送パターンと同一材質及び属準を有した軟磁性体パターンに検出電流を流しての機とで行なりパブルは区検出器とを具備してパブルメモリアーッパブル磁区検出器は、パブル磁区検出用の軟磁性は、パブル磁区検出用の軟磁性は、パブル磁区検出用のであるととを特徴とする磁気パブルメモリ案子。

2. 特許請求の範囲第1項記載の磁気パブルメモリ素子において、パブルメモリブロックを2個組合わせ、一方のブロックを奇数プロックとし、他方のブロックを偶数ブロックとしたことを特徴とする磁気パブルメモリ素子。

3. 発明の詳細な説明

本発明は磁気パブルメモリ素子の改良に関する。 . 従来より、磁気パブルメモリ装置に用いられる 磁気パブルメモリ業子には第1図に示す如き奇数 偶数プロックを持つ案子構成のものがある。これ たついて簡単に説明すると、1はガドリニウム・ ガリウム・ガーネット等の非磁性単結晶板の上に 液相エピタキシャル成長法により磁性ガーネット の薄膜を形成した基板であり、この基板の上に絶 綾材料のスペーサを介してパブル発生器2を有す る普入ライン3、スワップゲート又はトランスフ ァグート4、情報格納用の複数個のマイナールー . ブ5.レブリケータ6、銃出しライン7、パブル 検出器8等を有するブロックが形成されている。 このブロックはマイナールーブ5の間隔がパター ン形成上書込ライン 3 及び読出しライン 7 の 2 ピ ット毎であるのでパプルを駆動する回転磁界の 2 周期に1回の割合で答込み、銃出しが行をわれる。 従って高密度素子では図の如くブロックを2個並 ぺて形成し、A ブロックを奇数ブロック、 B ブロ

ックを偶数プロックとして交互に動作せしめるよ うになっている。そのため奇数プロックAの書込 みタイン3の長さを n ステップ。脱出しタイン 7 の長さをmステップとし、偶数ブロックBの書込 ライン3の長さはn+1ステップ。統出しライン 7の長さはm~1ステップとしている。このよう なパプルメモリ黒子において。そのパターン畝を 波らすことによりフォトマスクのコストを下げ、 更にその歩留り向上をはかるためフォトマスクに は片プロック分のみをパターニングし。実際の書 子は、それをウェーハ上に繰返し舞光した後、選 り合った各2ブロックで套数偶数ブロック構造を 構成する方法がとられている。ところが本方式の 素子は第1凶に示したようにマイナーループ5の 出口のレブリケータ 6 からパブル検出器 8 までの ステップ数を両プロックで1ステップずらして♪ く必要があり、そのため従来より各プロックのパ プル検出器8の構成として凶に示したように。2 段連続した検出パターン Di Da を用意しておき、 奇数プロックA、偶数プロックBを使い分ける方

モリ業子において、パブル磁区検出級は、パブル 磁区検出用の軟磁性体パターンを 3 段連続して配 離したものであることを特徴とするものである。

以下旅付図面に基づいて本発明の実施例につき詳細に説明する。

第3図に実施例のブロックの構成図を示す。本 実施例は磁気パブル発生器2及び2 mを有する書 込ライン3に、スワップゲート又はトランスファ ゲート4を介して複数個のマイナルーブ5が接続 され、このマイナルーブ5にレブリケータ6を介 して鋭出しタイン7が接続され、この読出しライン7にはパブル磁区検出器8が接続されている。 このパブル磁区検出器8には本発明の要点であるパルブ磁区検出用の軟磁性パターンD1、D2、D2 が連続して3段に形成されている。なか磁気パブル発生器2と2mとは1ビットずらして普込ライン3に接続されている。

とのように構成されたプロックの作用を猟 4 凶を用いて説明する。 第 4 凶は猟 3 凶のプロックを 盛板 1 の上に 2 傾並べて形成し、一方のプロック 法がとられている。ところがこの方式では両プロックの検出者の抵抗偏差が大きく ⁸人 が確めて懸い。また他の方法として組 2 図に示すように、前配 D1 D2 に加えダミーの検出パターン Dd1, D2 と Dd2 を配慮し、各プロックに対し D1 と Dd1, D2 と Dd2 のようにペアでノイズキャンセルを行なわせることがある。この方法では D1 と Dd1, D2 と Dd2 のペアに対してその抵抗偏盛が小さくなり ⁸人 が良くなるが、検出器手前のパブル磁区により発生する源遊磁界によるノイズ(クロストータノイズ)が問題となる場合がある。本発明はこれらの問題を解決するために案出されたものである。

とのため本発明においては、パーマロイ等の軟 磁性パターンを用いてパブル磁区の転送制御が行 なわれ、情報を格納する複数個のマイナーループ と、一対の脱出し及び審込ラインと、転送パター ンと同一材質及び膜厚を有する軟磁性パターンに 彼出電流を焼して磁気抵抗効果を利用し、パブル 磁区の検出を行なりパブル磁区検出器とを具備し てパブルメモリブロックを構成した磁気パブルメ

A を奇数プロックとし、他方のプロックBを偶数 プロックとしたものである。 そしてブロックAは 磁気パブル発生器 2を用いず1 のマイナループ 5 のスワップグート又はトランスファゲート4まで の書込ライン3の長さをコステップとし、また既 出しラインでは磁気パブル検出器8の軟磁性体パ ターン D: に接続して、∮1 のマイナル−プのレブ リケータ6より軟磁性体パターン Dz までをmステ ップとしており、これに対してブロックBは磁気 パプル発生器2gを用い 🛨0 のマイナループのス ワップゲート又はトランスファゲート4までの答 込ライン3の長さをn+1ステップとし、號出し ライン1は磁気パブル検出器8の軟磁性体パター ン D: に接続して、≠0 のマイナル~ブ 5 のレブリ ケータ6より軟磁性体パターンDiまでを m-1 ステップとしたものである。従ってブロックAと プロックBとは磁気パブル発生器より磁気パブル 段出器の軟磁性体パターンまでのステップ奴は何 一になり、かつマイナループへの書込み及び眺出 しはプロックAとプロックBとが父互に行なわれ るととになる。

そしてパブル磁区検出器の出力は第5回に示す 如き彼出方法で検出される。 図にかいて B: 及び B2 は各プロックのペアとなる軟磁性パターンの 抵抗を示したもので、第4回に示したプロックA においては D2. D2を、ブロックBにおいては D1. Daに相当する。またRa及びRaは外付抵抗であ り B: 及び B:と共にブリッジ回路を形成している。 との回路によるパブル磁区の検出は、パブル磁区 が検出器を通過する際 B1 或いは B2 が変化すると いう磁気抵抗効果を利用し、その終プリッジ回路 に生ずる非平衡電圧が出力として検知される。そ の際出力電圧は(B1-R2)に比例する差動出力で あるため Ri 及び Rz の抵抗偏差が小さいほど間相 ノイズのキャンセルが良くなり8~ が向上する。 すなわち第4図に示した如く。隣接した2つの検 出用軟磁性パターンをペアとして用いるサイドパ イサイド方式の本実施例ではパターン編等の場所 的変動に起因する抵抗偏差が小さく、8人が良く、 更に前述したクロストークノイズのキャンセリン

以上説明した如く本発明の磁気パブルメモリ素子はそのパブル磁区検出器に3段に並べて形成した軟磁性体パタンを用いることにより8分が良く。かつクロストークノイズを減少せしめることを可能としたものであって磁気パブルメモリ装置の信頼性の向上に寄与するものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図および第2図は従来の磁気パブルメモリ 業子の構成図、第3図は本発明にかかる実施例の 磁気パブルメモリ業子のブロック構成図、第4図 は本発明にかかる実施例の磁気パブルメモリ業子 の構成図、第5図はパブル磁区検出回路の回路図 である。

1 … 基板、 2 , 2 m … パブル磁区発生器、 3 … 書込 ライン、 4 … スワップゲート又はトランスファゲート。 5 … マイナループ、 6 … レブリケータ、 7 … 就出 ライン、 8 … パブル磁区検出器、 Di, Dg, D m … パブル磁区検出器用軟磁性体パターン。

